

## 关键指标

- 频率范围：DC~12GHz
- 隔离度：> 55dB@12GHz
- 插入损耗：1.4dB@12GHz
- 吸收式设计
- 纳秒级开关
- 芯片尺寸：1.4mm×1.25mm×0.1mm

## 产品简介

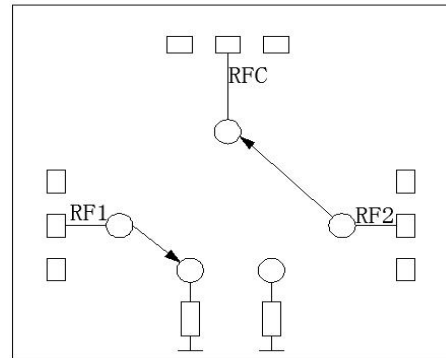
HX432160是一款宽带吸收式砷化镓pHEMT单刀双掷开关芯片，覆盖频段DC~12GHz，芯片在整个工作频段提供大于 40dB 的隔离度和小于 2.3dB 的插入损耗。采用0/-5V逻辑控制，无需外接电源偏置，无功率消耗。在工作频段具有优良的开关特性和端口驻波特性，适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块以及低功耗系统。

开关芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

## 典型应用

- 无线通信设备
- 雷达和电子对抗
- 军事和航天
- 仪器和仪表
- 微波无线电
- 测试和测量

## 功能框图



## 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, 控制电平=0/-5V, 50Ω系统)

指标	测试频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	DC~12GHz	-	-1.2	-	dB
隔离度	DC~12GHz	-	-45	-	dB
回波损耗 RFC(ON)	DC~12GHz	-	-15	-	dB
回波损耗 RF1,2,3(OFF)	DC~12GHz	-	-15	-	dB
输入 P <sub>1</sub> dB	DC~12GHz	-	30	-	dBm
输入 IP <sub>3</sub>	DC~12GHz	-	48	-	dBm
开关时间	DC~12GHz	-	15	-	ns

## 绝对最大额定值

射频输入功率	+30dBm	工作温度	-55°C~+85°C
控制电压范围	-3~0.2V	贮存温度	-65°C~+150°C
静电防护等级 (HBM)	Class 1A	沟道温度	150°C

控制电压

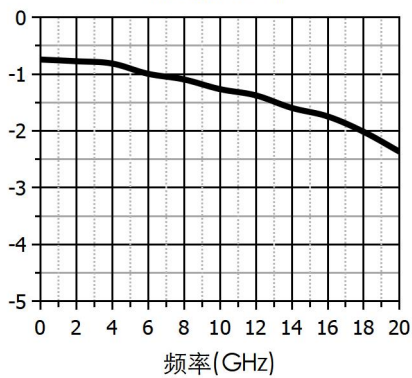
状态	偏置条件
低	0~0.2V
高	-3~-7V

真值表

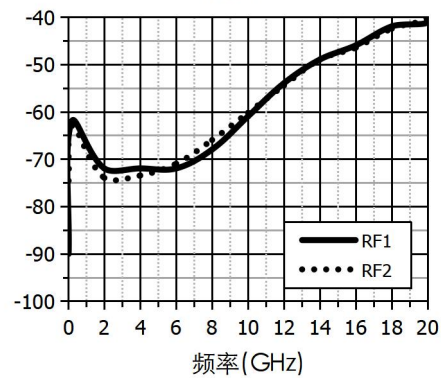
控制输入		通断状态	
A	B	RFC-RF1	RFC-RF2
高	低	ON	OFF
低	高	OFF	ON

典型测试曲线

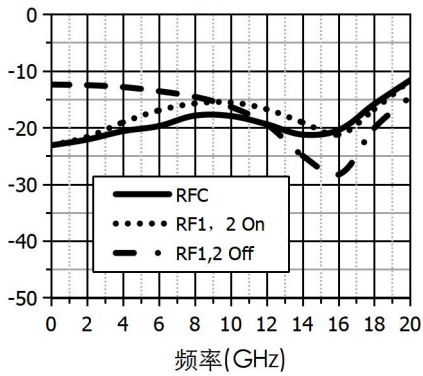
插入损耗(dB)



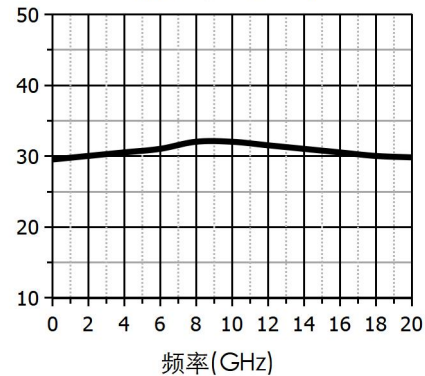
隔离度(dB)



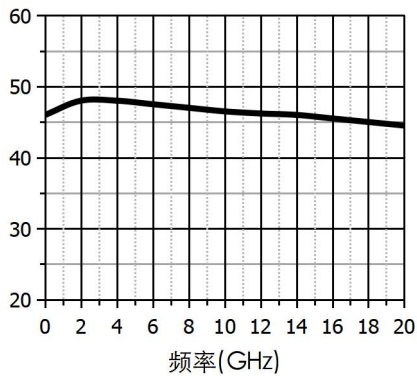
回波损耗(dB)



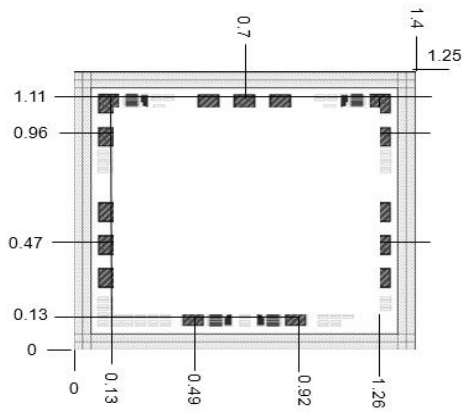
输入P<sub>1</sub>(dBm)



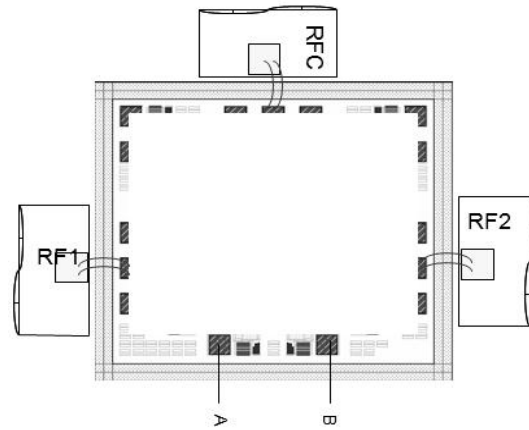
输入IP<sub>3</sub> (dBm)



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25 \mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400  $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。